

基于相干电子源的超快低能电子全息成像

王爱伟^{1,2,3},李驰^{1,2,3**},戴庆^{1,2,3*}

¹国家纳米科学中心中国科学院纳米光子材料与器件重点实验室(筹),北京100190; ²国家纳米科学中心中国科学院纳米卓越中心,北京100190; ³中国科学院大学材料与光电研究中心,北京100049

摘要 在原子尺度上研究电荷输运超快动力学特性,对于揭示光催化、光合作用等物理化学过程的机制有着重要意 义。与高能(>20 keV)电子束相比,低能(<500 eV)电子束在样品表面微弱的局域电场下有较大的散射截面,结合 全息成像机制,可以实现亚纳米级的空间分辨能力。因此,若采用具有飞秒时间分辨能力的超快相干电子源,低能 电子全息成像有望实现对原子尺度的电荷输运超快动力学过程的表征。首先介绍了超快低能电子全息成像的原 理,然后讨论了超快相干电子源的产生机制和性能,在此基础上,阐述了超快低能电子全息成像的研究现状并展望 了未来的发展趋势。

 关键词 全息;电子全息成像;低能电子成像;超快电子源;相干电子源;场发射;电荷输运超快动力学

 中图分类号 O462.3
 文献标志码 A

 DOI: 10.3788/CJL221372

1引言

研究原子尺度的电荷输运超快动力学过程,如载流 子激发、光致电荷分离、电荷转移及能量转移等,对于推 动光催化、光合作用、发光、光伏等领域的发展具有重要 意义。超快电子显微镜是实现高时间-空间分辨动力学 过程表征的必要手段。其中,超快透射电子显微镜 (TEM)^[1-3]和超快扫描电子显微镜(SEM)^[1,4]已经可以实 现纳米尺度乃至亚纳米尺度超快动力学过程的实空间观 测,如原子扩散过程^[5]、化学反应过程^[6-8]、相变过程^[9]、生 物大分子动力学^[10]等。超快 TEM、超快 SEM 通常采用 高能(>20 keV)电子束进行成像,然而,高能电子束散射 截面较小,导致其对样品局域微弱电场或光场的检测灵 敏度低,难以表征瞬态电荷输运过程[11]。相比之下,低能 电子显微镜利用能量小于500 eV的电子进行全息成像, 高能电子束在样品微弱的局域电场和纳米结构表面瞬态 光场下的散射截面和散射偏转角较大[11-13];同时,其空间 分辨率也可达10⁻¹⁰ m 量级^[14]。因此,低能电子全息成 像[11,15-16] 对电荷输运过程具有更高的探测灵敏度, 与超快 激光时间分辨技术结合时,有望实现原子级的局域电磁 场分布及电荷输运动力学表征[11,13,17-18]。

点电子源投影(简称"点投影")显微镜是实现低能 电子全息成像最简单的装置^[11,19]。由于无须匹配复杂 的电子光学系统,因此没有像差,其极限空间分辨率主要取决于电子源的相干性^[20],包含横向相干性和纵向相干性。其中,前者取决于电子源的虚源半径,后者取决于电子源的能量散度(简称能散)。据报道,使用原子级单晶钨针尖电子源可以实现对单个蛋白质分子^[21]、单个DNA分子^[22]、石墨烯晶格^[14,23]以及亚纳米尺度荷电状态^[24]等的静态全息成像。同时,采用超快电子源^[17,25-28],可获得亚10 fs的时间分辨率,并实现对电荷转移超快动力学过程的表征^[13,18,29]。然而,飞秒激光引起的热效应^[30-31]、光子能量失配^[32-35]和强光场加速^[36]等均会削弱电子源的相干性,因此基于金属针尖的电子全息成像空间分辨率仅能达到数纳米^[37-38]。故获取更高相干性的超快电子源是实现原子级空间分辨的超快低能电子全息成像的关键。

本文首先对低能电子全息成像的原理进行介绍, 然后对超快相干电子源的产生机理及发射电子的相干 性进行阐述,随后结合超快低能电子全息成像的研究 现状,阐明了相干电子源对提高空间分辨率的重要性, 最后对利用超快相干电子源提高超快电子全息成像的 空间分辨率进行展望。

2 超快低能电子全息成像的基本原理

低能电子全息成像[15-16]的原理如图1所示。整个

通信作者: *daiq@nanoctr. cn; **lichi@nanoctr. cn

收稿日期: 2022-10-31; 修回日期: 2022-12-05; 录用日期: 2022-12-10

基金项目:国家重点研发计划(2021YFC2802000)、国家自然科学基金(51972072,52072084,52222207,51925203)、广东省重 点领域研发计划(2020B0101020002)、广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院自主立项项目(2020GN0106)、中国科学院战略 性先导科技专项(B类)(XDB36000000)



图 1 超快电子全息成像原理图 Fig. 1 Schematic of ultrafast electron holography

装置主要包含三个部分:针尖点电子源、样品和荧光 屏。针尖与样品之间的距离为d,针尖与荧光屏之间 的距离为D,其成像放大倍数 $M = \frac{D}{d}$ 。当电子源具有 足够高的相干性且针尖与样品之间的距离足够小时, 电子的投影像不仅包含样品形貌引起的衬度变化,还 包含了透过样品的电子束与未经过透射样品的电子束 (参考电子束)叠加后形成的干涉条纹,即形成了全息 像^[11,15]。通过对全息像进行重构^[39-40],即可得到原子级 分辨的样品形貌像^[11,23,41]。

电子全息成像的极限分辨率(g)主要取决于电子 源相干性。电子源相干性主要分为横向相干性(也称 为空间相干性)和纵向相干性(也称为时间相干性)。 横向相干性用横向相干长度(ξ)来衡量,指在电子束辐 照的空间中任意两点发生相干的最大距离,可通过测 量干涉条纹区域的宽度得到^[38]。 ξ 取决于电子源的虚 源半径r,二者之间的关系是 $r = \frac{\lambda D}{\pi \xi}$ ^[38,42],其中 λ 是电 子束波长。又因 $g \approx 2r^{[43]}$,可见,电子源的虚源半径越 小,横向相干性则越高,空间分辨能力则越强。虚源半 径与针尖曲率半径、场增强因子以及材料功函数相关。 第 50 卷 第 1 期/2023 年 1 月/中国激光

具体地说,针尖的曲率半径越小、场增强因子越大及功 函数越大,则虚源半径越小。同时,干涉条纹的数量和 宽度亦会受纵向相干长度L的影响。若纵向相干性较 差,电子全息像中干涉条纹的数量会减小。L可由电 子飞行速度v和时间t相乘得到,即L=v•t^[43],其中飞

行速度 $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$,飞行时间 $t = \frac{h}{2\pi\Delta E}$,E为电子能量, m为电子质量, ΔE 为电子能散,h为普朗克常量。可见,电子能散 ΔE 越小,纵向相干性则越高,则越有利于提高空间分辨率。

在上述电子全息成像装置的基础上,引入飞秒激 光泵浦探测技术,可以实现超快动力学表征^[3,7-8],其原 理如图1所示。泵浦激光用来激发样品的超快过程, 探测激光用来激发电子发射,形成探测电子束。其时 间分辨能力取决于电子束的脉宽,脉宽越小,则时间分 辨能力越高。值得注意的是,电子从针尖到样品的传 输路径较短,可极大地避免电子束长程传输过程中的 脉宽展宽,因此,更容易实现高时间分辨率^[17,37]。

综上所述,发展具有高时空相干性和窄脉宽(飞秒-阿秒)的电子源,是实现原子尺度超快电子全息成像技术的关键。

3 超快相干电子源产生机制及发射电子的相干性

场发射(FE)是指在强电场条件下阴极材料释 放电子的过程,虚源半径可达亚纳米尺度,能散可 达1eV以下。相比于其他发射机制^[44],场发射是构筑 相干电子源的最优选择。通过使用脉冲激光激发阴极 的光电子发射,可获得超快电子源。光电子发射机制 包括:光子辅助场发射(PFE)、多光子光电子发射 (MPP)、阈上光电子发射(ATP)以及光场电子发射 (OFE),如图 2(a)~(d)所示^[25,36]。



图 2 不同的光电发射机制示意图^[25,36]。(a)FE;(b)PFE;(c)MPP;(d)OFE

Fig. 2 Schematics of different photoemission mechanisms^[25,36]. (a) FE; (b) PFE; (c) MPP; (d) OFE

3.1 FE的基本原理及电子的相干性

场发射的原理:利用外加强电场压缩发射材料表面 的真空势垒,形成电子隧穿发射,如图2(a)所示。场发 射现象是Fowler和Nordheim在1928年发现的。发射

电流强度可以由公式 $J = \frac{c_1(\beta E)^2}{\Phi} \exp\left(-\frac{c_2 \Phi^{\frac{3}{2}}}{\beta E}\right)$ 决

定^[45],其中J是发射电流密度, β 是局域场增强因子,E是电场强度, Φ 是材料功函数, $c_1 = \frac{e^3}{8\pi h}, c_2 = \frac{8\pi\sqrt{2m}}{3eh},$

e 是电子电荷量。一方面,J和β呈指数关系,且电子 主要由发射尖端的原子级凸起结构发射,因此,场发 射电子源具有较小的虚源半径。另一方面,由于隧穿 电子来自费米能级附近,因此可以实现较低的能散。 例如,单原子钨针尖发射源的虚源半径可以低至 0.14 nm^[46],能量散度最低可达0.2 eV^[38]。

3.2 PFE、MPP、ATP和OFE的基本原理及发射电子的相干性

PFE原理如图 2(b)所示,电子在吸收一个或者多 个光子的能量之后被激发到高能级,然后在外加静电 场的作用下隧穿到真空中。如果提高激光功率,发射 模式可从单光子 PFE模式转变为多光子 PFE。同一 电子吸收的光子个数等于光电流-光功率幂指数(*n*), 如图 3(a)所示^[32]。若电子吸收足够多的光子,使其能 量大于发射阈值,则即使没有静电场的存在,电子亦可 发射到真空中,该过程为 MPP,如图 2(c)和 3(b)所示。 其中 PFE产生的能谱峰与静态场发射峰的峰宽相近, 所发射的电子能散较小;而 MPP发射峰则较宽,所发 射的电子能散较大,如图 3(c)、(d)所示^[47]。





Fig. 3 Mechanisms of PFE, MPP and ATP. (a) Relationship between photoelectron emission and power of gold tip with curvature radius of 20 nm under laser irradiation where bias voltage of 880 V corresponds to PFE process and bias voltage of 0 V corresponds to MPP process^[32]; (b) relationship between photoelectron emissivity and bias at different optical powers^[32]; (c) PFE photoelectron spectroscopy^[47]; (d) MPP photoelectron spectroscopy^[47]; (e) ATP photoelectron spectroscopy^[33]; (f) photoelectron emissivity-light intensity curve^[36]

若继续增加激光的功率,则会有更多的光子参与到 电子激发过程中(光子数目比功函数所需光子数目多), 该过程称为ATP,如图3(e)中插图所示。ATP光电子 能谱会有更多的峰出现,每个峰对应一个光子能量,如 图3(e)所示^[33]。在ATP模式下,光电子能散较大。

随着光强的进一步增加,光电子发射进入OFE模

式^[36],其原理如图 2(d)所示。在 OFE 模式下,发射电流-光功率曲线会出现"弯曲",幂指数随着光功率的增加而减小,如图 3(f)所示。用 Keldysh参数 $\gamma = \sqrt{\frac{\Phi}{2U_p}}$ 可以描述这一发射行为,其中有质动力势 $U_p = \frac{e^2 F_{\text{eff}}^2}{4m\omega^2}$,

ω为光的频率, F_{eff}为针尖尖端的有效电场强度^[25,48]。 当 γ ≫1时,光电子发射机制为MPP;当 γ ≪1时,光电 子发射模式为纯净的OFE;而当γ≈1时,光电子发射 机制为MPP和OFE的混合机制^[25]。

当光电子发射完全进入到 OFE 模式时,光电子能 谱会出现"平台"现象。"平台"特征主要是电子在光场 中发生再散射所致,且能谱截止能量约为10U_p。 Krüger等^[49]通过使用超短脉冲激光激励钨针尖,实 现了 OFE [图 4(a)],并观察到了光电子发射能谱 [图4(b)]中的"平台"特征,截止能量可达~13 eV。

(a)

Distance from tip (nm)

Phase (π)

第50卷第1期/2023年1月/中国激光

OFE模式的另一个显著特征是,光电子发射会受到激 光脉冲载波包络相位(CEP)的调制,如图4(b)所示。 此外,当激光波长增加或者针尖曲率半径减小时,电子 在光场中的运动模式会由"颤动"转变为"亚周期",即 电子不再随着交变光场的变化发生往复运动,而是在 光场中经历了半个光波周期的加速后飞离光场,如图4(c) 所示^[48]。此时,光电子能谱的截止能量小于10U,,且 随着激光频率的减小,截止能量保持不变,如图4(d) 所示[48]。

Energy (eV) (b) 10 15 Modulation depth (%) log(Count rate) 2 0 0 Carrier-envelope phase offset (rad / $\pi)$ 0 10 15 10 20 30 0 5 Cut-off position Peak visibility (%) Energy (eV) 0 10 16 10 Normalized Normalized count rate (a.u.) count rate (a.u.) (c) (d)eslug 100 40 8.0 um Detected electrons per 6.3 μm 3.8 μm 10 2.6 um 0.8 µm 20 1 0.1 0 2.0 4.0 -1.0 0.0 1.0 3.0 0 50 100 150

利用OFE模式可以获得亚光学周期分辨的光电

图4 OFE机制。(a)OFE示意图^[49];(b)OFE能谱及光电流的CEP依赖关系^[49];(c)具有不同初始发射相位的电子的飞行轨迹仿真, 激光中心波长为8mm^[48];(d)不同激光波长下的光电子发射率与分析电压之间的关系^[48]

Analyser potential (--V)

Fig. 4 Mechanism of OFE. (a) Schematic of OFE^[49]; (b) OFE energy spectrum and CEP dependence of photocurrent^[49]; (c) simulated flight trajectories of electrons with different initial emission phases and laser center wavelength of 8 mm^[48]; (d) relationship between photoelectron emissivity and analyzer potential at different laser wavelengths [48]

第 50 卷 第 1 期/2023 年 1 月/中国激光

子发射,其电子束脉宽可达亚飞秒量级。然而,"颤动" 模式不仅使光电子能谱展宽,还使电子发射的初始方 向发生改变,并引起针尖虚源半径的增加,进而导致发 射电子的相干性变差。而"亚周期"模式有效避免了电 子的不均匀加速,可以实现更小的能散和虚源半径,电 子具有更高的相干性。

表1对比了不同光电子发射机制下电子的相干性。其中, PFE机制下电子具有更高的相干性, 原则上

可以通过该机制实现飞秒量级的原子分辨超快电子 源。然而,由于金属针尖本身具有连续能级,其电子服 从费米-狄拉克分布,因此其相干性还受到激光热效应 的影响^[30-31]。此外,为了进一步提高时间分辨率,必须 采用OFE机制,但必须同时降低其发射能散,这样才 能实现原子级分辨。金属针尖由于物性限制,很难进 一步降低能散,无法同时实现亚飞秒和原子级分辨。 综上所述,发展新型超快相干电子源材料势在必行。

表1 不同光电子发射机制下的电子相干性

rense under different photoelectron emi

Table 1 Election concrete and a uniterent photoelection emission mechanisms						
Photoemission mechanism	Electron pulse width	Electron energy spread	Virtual source size	Coherence		
PFE	fs	Small	Small	Largest		
MPP	fs	Large	Large	Larger		
ATP	fs	Larger	Larger	Large		
OFE	sub-fs	Largest	Largest	Small		

3.3 低维材料超快电子源及其相干性

与金属针尖相比,低维电子发射材料具有显著优势。第一,原子级的发射位点更容易提供原子级的虚 源半径,实现横向相干^[46]。第二,离散能带结构可以有 效避免费米-狄拉克分布的热展宽,从而降低电子发射 能散,实现纵向相干^[50]。此外,其丰富的电子结构可调 维度是电子源性能优化的重要基础。 例如,Li等^[51]利用单壁碳纳米管(简称碳管)尖 端半径小的优势,实现了空间光场的充分压缩,从而 抑制了电子的"颤动"效应,进而实现了高准直电子 发射,并获得了0.25 eV 的超低能量散度[图5(a)、 (b)],比金属低一个数量级^[50]。同时,Li等^[52]还提出 一种价带电子强光场发射理论模型[图5(c)]:一维 碳管具有离散的能带结构,在光场较弱的情况下,导



图 5 一维碳管 OFE。(a)碳管光场发射的微分电导曲线^[50];(b)碳管光场发射的光电子能谱^[51];(c)碳管光场发射示意图和价带发射示意图^[52];(d)OFE 光电流的 CEP 依赖关系^[52]

Fig. 5 OFE of one dimensional carbon tube. (a) Differential conductance curves of OFE through carbon tube^[50]; (b) photoelectron spectra of OFE through carbon tube^[51]; (c) schematics of OFE through carbon tube and valence band^[52]; (d) CEP dependence of OFE current^[52]

带电子发射占主导,随着光场的增强,价带电子开始的能量选择特性发射并占主导。在从导带发射向价带发射转变的过远小于钨针尖积中。今期一个极端非线性的发射行为值得脉冲。最表面构筑了

程中,会出现一个极端非线性的发射行为,使得脉冲激光的 CEP 对光电发射的调制深度高达 100%,如图 5(d)所示^[52]。以上工作证明,碳管超快电子源同时具备单色性好、准直度高和光学相位调制精度高三个优点,可以满足原子尺度时空分辨成像对电子源的要求。

此外, Purcell 等^[53]通过在 Pt 纳米尖端构筑零维 量子结构,实现了分立能级的共振隧穿场发射。共 振隧穿效应与激光法布里-珀罗腔谐振类似,具有极好 第50卷第1期/2023年1月/中国激光

的能量选择特性,使得发射电子的能散低至 64 meV, 远小于钨针尖的 0.2 eV。Esat 等^[54]在 Ag(111)单 晶表面构筑了基于单分子的电子发射体,实现了单 一能级的场发射,并观测到了单分子尺度的电子束 干涉条纹,因此,单分子电子源展现出了极好的相 干性[图 6(a)~(c)]。以此为理论基础,Duchet 等^[55]通过在钨针尖尖端修饰量子点,构筑了双势垒 隧穿结构,初步实现了 PFE效应主导的共振隧穿场 发射,其电子能散小于 0.5 eV[图 6(d)~(g)]。上 述工作也为超快相干电子源的构建提供了新 思路。



图6 基于零维纳米结构的场发射和光电子发射。(a)单晶银(111)基底上的花四甲酸二酐(PTCDA)分子场发射^[54];(b)基于 PTCDA分子的双势全隧穿结构^[54];(c)PTCDA分子场发射的干涉成像^[54];(d)钨针尖尖端修饰量子点示意图^[55];(e)基于量 子点的双势全隧穿模型^[55];(f)量子点静态场发射能谱^[55];(g)量子点光电子发射能谱^[55]

Fig. 6 Field emission and photoemission based on zero-dimension nanostructure. (a) Field emission of perylene-3, 4, 9, 10-tetracarboxylic acid dianhydride (PTCDA) molecule deposited on Ag(111) substrate^[54]; (b) double barrier tunneling structure based on PTCDA molecule ^[54]; (c) interference patter of PTCDA molecule FE^[54]; (d) illustration of quantum dot modified by apex of tungsten tip^[55]; (e) double barrier tunneling model based on quantum dot^[55]; (f) static field emission spectra of quantum dots^[55]; (g) quantum dot photoelectron emission spectra^[55]

表 2 汇总了影响发射电子相干性的因素。不 难看出,为了获得极限时空分辨的电子源,不仅需 要在选择合适电子发射机制的基础上优化激光和 环境参量,还需要优化设计发射材料。其中,以碳 管为代表的低维材料超快相干电子源是必然发展 趋势。

第 50 卷 第 1 期/2023 年 1 月/中国激光

表2 各种因素对发射电子相干性的影响

Table 2 Influence of different factors on electron coherence

Factor	Electron energy spread	Virtual source size	Coherence
Laser power	Positive correlation	Positive correlation	Negative correlation
Laser wavelength	Positive correlation	Positive correlation	Negative correlation
Radius of curvature	Positive correlation	Positive correlation	Negative correlation
Quantized level	Negative correlation		Positive correlation
Thermal effect	Positive correlation		Negative correlation

4 超快低能电子全息成像的研究现状

4.1 静态低能电子全息成像的研究现状

1948年Gabor¹⁶就已经预测了电子全息成像可 实现原子尺度空间分辨表征,然而,由于受到原子级高 相干电子源制造技术和扫描探针控制技术的限制,该 预测并没有在实验上实现。直到20世纪90年代,随着 相关技术的发展,基于点投影显微镜的低能电子全息 成像得以实现¹⁵,且研究者完成了对石墨烯原子晶格 以及单个生物大分子的高分辨表征。 例如,Longchamp等^[14]基于单晶钨(111)针尖电 子源,在针尖-样品距离约为380 nm的情况下,采用 58 eV的低能电子,获得了单层石墨烯的原子分辨图 像,如图7(a)所示。Longchamp等^[21]随后又将蛋白质 分子沉积到单层石墨烯衬底上,进行了低能电子全息 成像。在实验中,针尖-分子样品距离约为100 nm,电 子的能量为60~140 eV,获得了单个蛋白质分子的电 子全息图,并在重构之后得到了单个蛋白质分子的形 貌图,分辨率为0.7~0.8 nm,如图7(b)所示。Fink 等^[22]利用能量为70 eV的电子,测得了单根DNA分子



图 7 低能电子全息成像。(a)低能电子全息成像原理图及全息像重构之后得到的石墨烯形貌图和放大图^[14];(b)DNA分子的全息成像和重构之后的形貌图^[21];(c)蛋白质分子全息成像及重构之后的形貌图^[22]

Fig. 7 Low energy electron holography. (a) Schematic of low-energy electron holography and graphene topography and detailed topography reconstructed from hologram^[14]; (b) DNA molecular hologram and its reconstructed topography^[21]; (c) protein molecular hologram and its reconstructed topography^[22]

的电子全息成像,并通过重构得到了DNA分子形貌 图,如图7(c)所示。

具有小虚源半径和低能散的相干电子源是实现高 空间分辨电子全息的基础。上述高分辨全息成像均依 赖于高相干的原子级单晶钨针尖电子源,其尖端仅有 一个或三个原子发射电子^[56],虚源半径极小,仅0.14 nm^[46], 且能散低至0.2 eV。由于基于单色电子源的电子全 息成像分辨率等于2倍的虚源半径,因此,单晶钨电子 源可以使得电子全息成像获得近单原子级的空间分辨 能力。电子全息的空间分辨能力可以与 TEM 和 SEM 相媲美。

4.2 超快低能电子点投影成像及电荷输运超快动力 学过程研究

将超快激光时间分辨技术与电子全息成像相结合,有望实现原子级空间分辨和飞秒时间分辨的超快动力学表征。然而,引入的超快激光必然会引起电子 源相干性的恶化,超快电子全息成像的实验难度远高 于静态电子全息成像。当电子源相干性无法满足全 息成像要求时,只能进行单纯的点投影放大成像 [图 8(a)]。即使如此,由于电子源与样品之间的距



图8 超快低能电子点投影成像及电荷输运超快动力学过程研究。(a)超快低能电子点投影成像原理图^[18];(b)p-i-n InP 纳米线结构 示意图和点投影形貌图^[18];(c)p-i-n InP 纳米线体内载流子瞬态响应曲线^[18];(d)基于光栅结构的传播等离激元聚焦原理图和 InP 纳米线点投影成像原理图^[17];(e)InP 纳米线点投影形貌图^[17];(f)基于光电流的激光自相关相干测试^[17]

Fig. 8 Ultrafast low-energy electron point projection imaging and its application in ultrafast charge transport characterization.
 (a) Schematic of ultrafast low-energy electron point projection imaging^[18]; (b) schematics of p-i-n InP nanowire structure and point projection imaging^[18]; (c) carrier transient response curve in p-i-n InP nanowires^[18]; (d) schematic of laser focusing through propagating plasma focusing based on grating structure and schematic of InP nanowire point projection imaging^[17]; (e) InP nanowire point projection topography^[17]; (f) photocurrent-based laser autocorrelation interference measurement^[17]

离超短,因此超快电子全息成像可以有效避免电子 长程传输过程中的脉宽展宽,在时间分辨率方面相 比超快 TEM 更具优势,所以同样引起了研究人员的 关注。

例如, Muller等^[18]将脉冲激光引入到低能电子成 像系统中[图8(a)], 以曲率半径为20~100 nm 的钨 针尖作阴极, 针尖与样品之间的距离控制在20 μm, 电子能量设置为90 eV, 获得了放大近5000倍的点 投影成像。最终, 实现了数十纳米分辨的 p-i-n InP 纳米线形貌测量[图8(b)],并测得了纳米线内部激光 脉冲诱导的持续近100 fs 的电流瞬态变化, 如图8(c) 所示。通过在金纳米针尖远离尖端的位置构筑光栅 结构, 可以将泵浦激光和探测激光分离, 避免两束光 之间的串扰, 如图8(d)所示。这样就可以把针尖和 样品的距离控制到3 μm 以下, 进而将放大倍数提高

第 50 卷 第 1 期/2023 年 1 月/中国激光

到 31000,并成功实现了 PN 结附近电场分布的检测,如图 8(e)所示^[17]。同时,其时间分辨率可达 10 fs[图 8(f)],远优于超快 TEM 数百飞秒的时间分 辨能力^[57]。以此为基础,Vogelsang等^[29]使用带有光 栅结构且曲率半径小于 20 nm 的金针尖作电子源, 设置针尖-样品距离约为2.7 μm,电子能量为 60 eV, 实现了 20 nm 空间分辨的双孔纳米天线形貌表征, 测得了持续 25 fs 的激光诱导的电荷转移过程,如 图 9(a)所示。Hergert等^[13]则依托类似装置实现了 低能电子与局域电磁场相互作用的动力学过程的实 空间直接观测,如图 9(b)、(c)所示。以上实验报道 表明,低能电子对微弱的局域电场和纳米结构表面 的瞬态光场具有出色的探测能力。相关研究结果对 电荷集体激发乃至束缚态能级的光激发研究均具有 重要意义^[12,17]。



图9 超快低能电子点投影成像在电荷转移超快动力学研究中的应用。(a)双孔纳米天线结构的超快点投影成像^[29];(b)纳米天线结构中电子能量分布的超快表征原理图^[13];(c)0延时的纳米天线点投影成像^[13];(d)纳米天线左侧区域的电子能量瞬态变化^[13];(e)纳米天线中间区域的电子能量瞬态变化^[13]

Fig. 9 Application of ultrafast low-energy electron point projection imaging in study of ultrafast charge transport dynamics. (a) Ultrafast point projection imaging of double-hole nanoantenna structure^[29]; (b) schematic of ultrafast characterization of electron energy distribution in nanoantenna structure^[13]; (c) point projection imaging of nanoantenna at zero pulse delay^[13]; (d) transient variation of electron energy at left area of nanoantenna^[13]; (e) transient variation of electron energy at middle area of nanoantenna^[13].

4.3 超快低能电子全息成像

近年来,随着超快电子源研究的不断深入,单色性 和虚源半径不断得到优化,因此超快低能电子全息成 像得以成功实现。

例如,Ehberger等^[38]使用单晶钨相干电子源,对多 壁碳管的超快电子全息成像进行了探索,如图 10 所 示。其核心技术如下:调控外加电场,使得入射飞秒激 光的光子能量与钨针尖的有效功函数相匹配,从而实 现了低能散(0.51 eV)超快电子发射。因此,在针尖曲 率半径约为10 nm、碳管样品到钨针尖距离小于1 μm 以及电子能量为41 eV 的情况下,成功获得了多壁碳 管的超快电子全息图像,如图 10(b)所示。根据虚源 半径和相干长度的关系计算得,有激光辐照时电子源 的虚源半径为(0.8±0.05)nm,可获得的极限空间分 辨率为(1.6±0.1)nm。

在此之后, Vogelsang 等^[37]通过使用中心波长为 1.8 μm和2.2 μm的激光分别激发单晶金针尖(半径 为9 nm)和单晶钨针尖(半径为6 nm),进行了超快低 能电子全息成像。他们在两种针尖表面构筑了光栅结 构进行激光聚焦[图 10(c)], 以减小针尖-样品距离。 由于激光波长较长, 单个光子能量低于功函数, 因此



图 10 超快低能电子全息成像。(a)光电子发射及电子干涉实验原理^[38];(b)激光辐照前、后钨针尖场发射干涉条纹^[38];(c)超快电子 全息成像原理^[37];(d)基于发射电流的脉冲自相关干涉测量^[37];(e)金针尖光电子发射干涉条纹^[37];(f)钨针尖光电子发射干涉 条纹^[37]

Fig. 10 Ultrafast low-energy electron holography. (a) Experimental principle of photoelectron emission and electron interference^[38];
 (b) tungsten tip field emission interference fringes before and after laser excitation^[38];
 (c) schematic of ultrafast electron holography^[37];
 (d) pulse autocorrelation interferencetry based on emission current^[37];
 (e) gold tip photoemission interference fringes^[37];
 (f) tungsten tip photoemission interference fringes^[37];

两个针尖光电子发射均需工作在 MPP 机制下。根据 观测到的碳管超快全息图像[图 10(e)、(f)]进行计算, 金针尖和钨针尖的虚源半径分别为4.7 nm和1.4 nm,对 应的电子全息成像空间分辨率分别为9.4 nm和2.8 nm。 成像时间分辨率可达18 fs[图 10(d)]。与上述 PFE 相 比, MPP 机制提供的多光子能量与功函数的失配度更 高。同时,激光功率高也会产生更强的热效应。这些 因素都会导致电子源能量散度的提升。因此,文献[37] 中报道的虚源半径远大于文献[38]中紫外光激发的超 快相干电子源。

虽然研究人员通过优化激光参量改善了超快电子 源的单色性,但基于传统金属针尖仍然很难实现静态 场发射的相干性。因此,利用低维纳米材料在几何尺 寸和电子结构方面的优势,构筑具有更高相干性的超 快电子源是电子全息成像技术的一个重要发展趋势。

5 总结与展望

综上所述,超快低能电子全息成像技术在原子尺 度电荷超快动力学表征方面展现出重要的应用前景。 其成像的极限空间分辨能力主要由超快电子源的相干 性决定。基于传统金属纳米针尖的超快电子源受物性 限制,难以进一步提高相干性。相比之下,以碳管为代 表的低维纳米材料电子源具有原子尺度的发射位点和 量子化的分立能级,是突破相干性瓶颈的重要基础。 碳管具有丰富的碳体手性结构和尖端量子结构,为高 性能电子源的优化设计带来了更多的调控维度。在未 来,通过结合基于第一性原理的原子尺度材料设计和 "自下而上"的原子制造技术,获得最优的碳管发射结 构,有望获得接近不确定原理极限的超快电子源,进一 步推动原子级分辨超快电子全息成像技术的发展。

参考文献

- Zewail A H. Four-dimensional electron microscopy[J]. Science, 2010, 328(5975): 187-193.
- [2] Barwick B, Park H S, Kwon O H, et al. 4D imaging of transient structures and morphologies in ultrafast electron microscopy[J]. Science, 2008, 322(5905): 1227-1231.
- [3] Lobastov V A, Srinivasan R, Zewail A H. Four-dimensional ultrafast electron microscopy[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2005, 102 (20): 7069-7073.
- [4] Yang D S, Mohammed O F, Zewail A H. Scanning ultrafast electron microscopy[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010, 107(34): 14993-14998.
- [5] Lorenz U J, Zewail A H. Nanofluidics. Observing liquid flow in nanotubes by 4D electron microscopy[J]. Science, 2014, 344 (6191): 1496-1500.

- [6] Gao M, Lu C, Jean-Ruel H, et al. Mapping molecular motions leading to charge delocalization with ultrabright electrons[J]. Nature, 2013, 496(7445): 343-346.
- [7] Srinivasan R, Feenstra J S, Park S T, et al. Dark structures in molecular radiationless transitions determined by ultrafast diffraction[J]. Science, 2005, 307(5709): 558-563.
- [8] Ihee H, Lobastov V A, Gomez U M, et al. Direct imaging of transient molecular structures with ultrafast diffraction[J]. Science, 2001, 291(5503): 458-462.
- [9] van der Veen R M, Kwon O H, Tissot A, et al. Singlenanoparticle phase transitions visualized by four-dimensional electron microscopy[J]. Nature Chemistry, 2013, 5(5): 395-402.
- [10] Fitzpatrick A W P, Vanacore G M, Zewail A H. Nanomechanics and intermolecular forces of amyloid revealed by four-dimensional electron microscopy[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, 112(11): 3380-3385.
- [11] Latychevskaia T. Holography and coherent diffraction imaging with low-(30-250 eV) and high-(80-300 keV) energy electrons: history, principles, and recent trends[J]. Materials, 2020, 13(14): 3089.
- [12] Hergert G, Wöste A, Groß P, et al. Strong inelastic scattering of slow electrons by optical near fields of small nanostructures[J]. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2021, 54(17): 174001-174008.
- [13] Hergert G, Wöste A, Vogelsang J, et al. Probing transient localized electromagnetic fields using low-energy point-projection electron microscopy[J]. ACS Photonics, 2021, 8(9): 2573-2580.
- [14] Longchamp J N, Latychevskaia T, Escher C, et al. Graphene unit cell imaging by holographic coherent diffraction[J]. Physical Review Letters, 2013, 110(25): 255501.
- [15] Fink H W, Stocker W, Schmid H. Holography with low-energy electrons[J]. Physical Review Letters, 1990, 65(10): 1204-1206.
- [16] Gabor D. A new microscopic principle[J]. Nature, 1948, 161 (4098): 777-778.
- [17] Müller M, Kravtsov V, Paarmann A, et al. Nanofocused plasmondriven sub-10 fs electron point source[J]. ACS Photonics, 2016, 3 (4): 611-619.
- [18] Müller M, Paarmann A, Ernstorfer R. Femtosecond electrons probing currents and atomic structure in nanomaterials[J]. Nature Communications, 2014, 5: 5292.
- [19] Hsu W H, Chang W T, Lin C Y, et al. Low-energy electron point projection microscopy/diffraction study of suspended graphene[J]. Applied Surface Science, 2017, 423: 266-274.
- [20] Spence J C H, Qian W, Silverman M P. Electron source brightness and degeneracy from Fresnel fringes in field emission point projection microscopy[J]. Journal of Vacuum Science &. Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films, 1994, 12(2): 542-547.
- [21] Longchamp J N, Rauschenbach S, Abb S, et al. Imaging proteins at the single-molecule level[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2017, 114 (7): 1474-1479.
- [22] Fink H W, Schmid H, Ermantraut E, et al. Electron holography of individual DNA molecules[J]. Journal of the Optical Society of America A, 1997, 14(9): 2168.
- [23] Longchamp J N, Latychevskaia T, Escher C, et al. Low-energy electron transmission imaging of clusters on free-standing graphene [J]. Applied Physics Letters, 2012, 101(11): 113117.
- [24] Latychevskaia T, Wicki F, Longchamp J N, et al. Direct observation of individual charges and their dynamics on graphene by low-energy electron holography[J]. Nano Letters, 2016, 16(9): 5469-5474.
- [25] Zhou S H, Chen K, Cole M, et al. Ultrafast field-emission electron sources based on nanomaterials[J]. Advanced Materials, 2019, 31(45): 1805845.
- [26] Bainbridge A R, Barlow Myers C W, Bryan W A. Femtosecond

第50卷第1期/2023年1月/中国激光

few- to single-electron point-projection microscopy for nanoscale dynamic imaging[J]. Structural Dynamics, 2016, 3(2): 023612.

- [27] Gulde M, Schweda S, Storeck G, et al. Ultrafast low-energy electron diffraction in transmission resolves polymer/graphene superstructure dynamics[J]. Science, 2014, 345(6193): 200-204.
- [28] Quinonez E, Handali J, Barwick B. Femtosecond photoelectron point projection microscope[J]. Review of Scientific Instruments, 2013, 84(10): 103710.
- [29] Vogelsang J, Hergert G, Wang D, et al. Observing charge separation in nanoantennas via ultrafast point-projection electron microscopy[J]. Light: Science & Applications, 2018, 7: 55.
- [30] Cho B, Ichimura T, Shimizu R, et al. Quantitative evaluation of spatial coherence of the electron beam from low temperature field emitters[J]. Physical Review Letters, 2004, 92(24): 246103.
- [31] Siwick B J, Dwyer J R, Jordan R E, et al. An atomic-level view of melting using femtosecond electron diffraction[J]. Science, 2003, 302(5649): 1382-1385.
- [32] Ropers C, Solli D R, Schulz C P, et al. Localized multiphoton emission of femtosecond electron pulses from metal nanotips[J]. Physical Review Letters, 2007, 98(4): 043907.
- [33] Schenk M, Krüger M, Hommelhoff P. Strong-field abovethreshold photoemission from sharp metal tips[J]. Physical Review Letters, 2010, 105(25): 257601.
- [34] Barwick B, Corder C, Strohaber J, et al. Laser-induced ultrafast electron emission from a field emission tip[J]. New Journal of Physics, 2007, 9(5): 142.
- [35] Yanagisawa H, Hafner C, Doná P, et al. Optical control of fieldemission sites by femtosecond laser pulses[J]. Physical Review Letters, 2009, 103(25): 257603.
- [36] Krüger M, Lemell C, Wachter G, et al. Attosecond physics phenomena at nanometric tips[J]. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 2018, 51(17): 172001.
- [37] Vogelsang J, Talebi N, Hergert G, et al. Plasmonic-nanofocusingbased electron holography[J]. ACS Photonics, 2018, 5(9): 3584-3593.
- [38] Ehberger D, Hammer J, Eisele M, et al. Highly coherent electron beam from a laser-triggered tungsten needle tip[J]. Physical Review Letters, 2015, 114(22): 227601.
- [39] Latychevskaia T, Fink H W. Practical algorithms for simulation and reconstruction of digital in-line holograms[J]. Applied Optics, 2015, 54(9): 2424-2434.
- [40] Latychevskaia T, Longchamp J N, Fink H W. When holography meets coherent diffraction imaging[J]. Optics Express, 2012, 20 (27): 28871-28892.
- [41] Fink H W, Schmid H, Kreuzer H J, et al. Atomic resolution in lensless low-energy electron holography[J]. Physical Review Letters, 1991, 67(12): 1543-1546.
- [42] Chang C C, Kuo H S, Hwang I S, et al. A fully coherent electron beam from a noble-metal covered W(111) single-atom emitter[J]. Nanotechnology, 2009, 20(11): 115401.
- [43] Binh V T, Semet V. Interactions of low-energy coherent electron beams with nano-scale objects: a study by Fresnel projection microscopy[J]. Ultramicroscopy, 1998, 73(1/2/3/4): 107-117.
- [44] Zuo J M, Spence J C H. Electron sources[M]// Zuo J M, Spence J C H. Advanced transmission electron microscopy. New York: Springer, 2016: 193-206.
- [45] Fowler R H, Nordheim L. Electron emission in intense electric fields[J]. Proceedings of the Royal Society A, 1928, 119(781): 173-181.
- [46] Schmid H, Fink H W. Carbon nanotubes are coherent electron sources[J]. Applied Physics Letters, 1997, 70(20): 2679-2680.
- [47] Yanagisawa H, Hengsberger M, Leuenberger D, et al. Energy distribution curves of ultrafast laser-induced field emission and their implications for electron dynamics[J]. Physical Review Letters, 2011, 107(8): 087601.
- [48] Herink G, Solli D R, Gulde M, et al. Field-driven photoemission from nanostructures quenches the quiver motion[J]. Nature, 2012,

483(7388): 190-193.

- [49] Krüger M, Schenk M, Hommelhoff P. Attosecond control of electrons emitted from a nanoscale metal tip[J].Nature, 2011, 475 (7354): 78-81.
- [50] Li C, Zhou X, Zhai F, et al. Carbon nanotubes: carbon nanotubes as an ultrafast emitter with a narrow energy spread at optical frequency[J]. Advanced Materials, 2017, 29(30): 1701580.
- [51] Li C, Zhou X, Zhai F, et al. Quiver-quenched optical-fieldemission from carbon nanotubes[J]. Applied Physics Letters, 2017, 111(13): 133101.
- [52] Li C, Chen K, Guan M X, et al. Extreme nonlinear strong-field photoemission from carbon nanotubes[J]. Nature Communications, 2019, 10: 4891.
- [53] Purcell S T, Binh V T, Garcia N. 64 meV measured energy

第 50 卷 第 1 期/2023 年 1 月/中国激光

dispersion from cold field emission nanotips[J]. Applied Physics Letters, 1995, 67(3): 436-438.

- [54] Esat T, Friedrich N, Tautz F S, et al. A standing molecule as a single-electron field emitter[J]. Nature, 2018, 558(7711): 573-576.
- [55] Duchet M, Perisanu S, Purcell S T, et al. Femtosecond laser induced resonant tunneling in an individual quantum dot attached to a nanotip[J]. ACS Photonics, 2021, 8(2): 505-511.
- [56] Fink H W. Point source for ions and electrons[J]. Physica Scripta, 1988, 38(2): 260-263.
- [57] Vanacore G M, Fitzpatrick A W P, Zewail A H. Fourdimensional electron microscopy: ultrafast imaging, diffraction and spectroscopy in materials science and biology[J]. Nano Today, 2016, 11(2): 228-249.

Ultrafast Low-Energy Electron Holography Based on Coherent Electron Source

Wang Aiwei^{1,2,3}, Li Chi^{1,2,3**}, Dai Qing^{1,2,3*}

¹CAS Key Laboratory of Nanophotonic Materials and Devices, National Center for Nanoscience and Technology, Beijing 100190, China;

²CAS Center for Excellence in Nanoscience, National Center for Nanoscience and Technology, Beijing 100190, China; ³Center of Materials Science and Optoelectronics Engineering, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049,

China

Abstract

Significance Solar energy utilization is crucial for all life on earth. For example, photosynthesis in green plants, which is vital for humans and other living creatures to have access to food, depends on solar energy. Furthermore, solar energy is the cleanest energy source and has various other applications, including solar–electric energy conversion through photovoltaics and solar–chemical energy through photosynthesis and photocatalysis. However, the conversion efficiency is currently low and needs to be improved. Therefore, the study of ultrafast dynamic processes at the atomic scale, such as carrier excitation, photoinduced charge separation, charge transfer, and energy transfer, is crucial for revealing the underlying physical mechanisms of photosynthesis, photovoltaic, and photocatalysis, which is significant for improving the conversion efficiency of solar energy.

Ultrafast electron microscopy is required to realize the high temporal-spatial resolution characterization of ultrafast dynamic processes. The ultrafast transmission electron microscope (TEM) and the ultrafast scanning electron microscope (SEM) have realized the real space observation of ultrafast dynamic processes at the nanoscale and atomic levels. These processes include atomic diffusion, chemical reaction, phase change, and biological macromolecular dynamics. Ultrafast TEM and ultrafast SEM typically use high-energy (>20 keV) electron beams for imaging. However, owing to the small scattering cross-section of high-energy electrons, the detection sensitivity to the weak local electric or optical field of the sample is low. Therefore, the transient charge transport process is challenging to characterize. In contrast, low-energy electrons with energy less than 500 eV have large scattering cross-section and scattering deflection angle for the weak local electric field in the sample and transient light field on the surface of nanostructures. Moreover, characterization with spatial resolution in the order of 10^{-10} m can be achieved via electron holography. Therefore, when combined with ultrafast temporal-resolution technology, the low-energy electron holography is expected to characterize the local electromagnetic field distribution and charge transport at the atomic level.

Point electron source projection microscope (referred to as "point projection") is the simplest device to realize low-energy electron holography. By employing the laser-pumped ultrafast electron source, ultrafast low-energy electron holography can be achieved. Because matching the complex electron optical system is not needed, there is no aberration. The spatial resolution mainly depends on the electron source coherence. Therefore, an ultrafast coherent electron source is required to achieve ultrafast high spatial-resolution holography. In the past few years, many mechanisms to generate ultrafast electrons are discovered, including photon-assisted field emission (PFE), multiphoton photoemission (MPP), above-threshold photoemission (ATP), and optical field emission (OFE). Based on these mechanisms, ultrafast coherent electron sources have been built, and high temporal-spatial resolution holography has been achieved. Therefore, the current research is essential to guide the future development of this field more rationally.

Progress First, the fundamental mechanism of ultrafast electron sources is described in detail, and their coherence is discussed. The ultrafast electron source can be realized via laser pulse-modulated field emission. Photoelectron-emission mechanisms, including PFE, MPP, ATP, and OFE, generate ultrafast electron emission, which can achieve femtosecond or even up to sub-femtosecond

temporal resolution. Among these mechanisms, the electrons emitted under the PFE mechanism have a low-energy dispersion equivalent to the static field emission (Table 1), resulting to high coherence. Second, low-dimensional materials, such as one-dimension carbon nanotubes (Fig. 5) and zero-dimension quantum dots, have atomic-scale curvature radii and discrete energy levels induced via quantum confinement effect, enabling the high-coherent emitted electrons. Then, the influence of laser power, laser wavelength, radius of curvature, and discrete energy levels on electron source coherence is summarized, as shown in Table 2. Lastly, the development of static and ultrafast low-energy electron holography is introduced. Furthermore, based on high-coherent tungsten tip electron sources, static holographic imaging of single protein molecule, single DNA molecule, graphene lattice, and sub-nanometer scale charge state can be achieved. Using ultrafast electron sources, the sub-10 fs temporal resolution characterization of the ultrafast dynamic process of photogenerated carriers and nanogap charge transfer in semiconductor nanowires can be realized. However, the spatial resolution of electron holography can only reach several nanometers, as shown in Fig. 10, much larger than that in the static cases. The main reason is that the thermal effect, photon energy mismatch, and strong light field acceleration caused by femtosecond laser weaken the electron source coherence, reducing the spatial resolution of the ultrafast holography.

Conclusions and Prospects In conclusion, further improvement of ultrafast electron source coherence based on traditional metal nanotip is challenging owing to its physical property limitation. In contrast, low-dimensional nanomaterial electron sources, such as electron source based on carbon nanotubes, have atomic-scale emission sites and quantized discrete energy levels, which is an important basis for breaking the coherence bottleneck. Additionally, carbon nanotubes have rich carbon-chiral structures and cutting-edge quantum structures, bringing more regulatory dimensions for the optimal design of high-performance electronic sources. In the future, we will develop the optimal carbon tube emission structure by combining the atomic-scale material design based on the first principle and the "bottom-up" atomic manufacturing technology. This structure is expected to achieve an ultrafast electron source close to the uncertainty principle limit and promote the development of the atomic resolution of ultrafast electron holographic imaging technology.

Key words holography; electron holography; low-energy electron imaging; ultrafast electron source; coherent electron source; field emission; charge transport ultrafast dynamics